



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4937.37—2025/IEC 60749-37:2022

---

## 半导体器件 机械和气候试验方法 第 37 部分：采用加速度计的板级跌落 试验方法

Semiconductor devices—Mechanical and climatic test methods—  
Part 37: Board level drop test method using an accelerometer

(IEC 60749-37: 2022, IDT)

2025-12-31 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会

目 次

前言 ..... III

引言 ..... V

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 试验设备和器件 ..... 2

5 试验程序 ..... 4

6 失效判据和失效分析 ..... 7

7 说明 ..... 7

附录 A（资料性） 标准电路板结构、材料、设计和版图 ..... 9

参考文献 ..... 13

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 4937《半导体器件 机械和气候试验方法》的第37部分。GB/T 4937 已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：低气压；
- 第3部分：外部目检；
- 第4部分：强加速稳态湿热试验(HAST)；
- 第8部分：密封；
- 第10部分：机械冲击 器件和组件；
- 第11部分：快速温度变化 双液槽法；
- 第12部分：扫频振动；
- 第13部分：盐雾；
- 第14部分：引出端强度(引线牢固性)；
- 第15部分：通孔安装器件的耐焊接热；
- 第16部分：粒子碰撞噪声检测(PIND)；
- 第17部分：中子辐照；
- 第18部分：电离辐射(总剂量)；
- 第19部分：芯片剪切强度；
- 第20部分：塑封表面安装器件耐潮湿和焊接热综合影响；
- 第20-1部分：对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输；
- 第21部分：可焊性；
- 第22部分：键合强度；
- 第23部分：高温工作寿命；
- 第24部分：加速耐湿无偏置强加速应力试验；
- 第25部分：温度循环；
- 第26部分：静电放电(ESD)敏感度测试 人体模型(HBM)；
- 第27部分：静电放电(ESD)敏感度测试 机器模型(MM)；
- 第29部分：闩锁试验；
- 第30部分：非密封表面安装器件在可靠性试验前的预处理；
- 第31部分：塑封器件的易燃性(内部引起的)；
- 第32部分：塑封器件的易燃性(外部引起的)；
- 第33部分：加速耐湿 无偏置高压蒸煮；
- 第34部分：功率循环；
- 第35部分：塑封电子元器件的声学显微镜检查；
- 第36部分：稳态加速度；
- 第37部分：采用加速度计的板级跌落试验方法；
- 第38部分：带存储的半导体器件的软错误试验方法；

- 第 39 部分：半导体器件用有机材料的潮气扩散率和水溶解度测量；
- 第 40 部分：采用应变仪的板级跌落试验方法；
- 第 42 部分：温湿度贮存；
- 第 44 部分：半导体器件的中子辐照单粒子效应(SEE)试验方法。

本文件等同采用 IEC 60749-37:2022《半导体器件 机械与气候试验方法 第 37 部分：采用加速度计的板级跌落试验方法》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本文件起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所、广州毅昌科技股份有限公司、河北中电科航检测技术服务有限公司、安徽钜芯半导体科技有限公司、广州海关技术中心、广东仁懋电子有限公司。

本文件主要起草人：高东阳、魏兵、陈汝文、彭浩、赵海龙、裴选、宋玉玺、武利会、曹孙根、王英程、吴福娣、蓝春浩、仇亮。

## 引 言

半导体器件是电子行业产业链中的通用基础产品,为电子系统中的最基本单元,GB/T 4937《半导体器件 机械和气候试验方法》是半导体器件进行试验的基础性和通用性标准,对于评价和考核半导体器件的质量和可靠性起着重要作用。拟由 44 个部分构成。

- 第 1 部分:总则。目的在于规定半导体器件机械和气候试验方法的通用准则。
- 第 2 部分:低气压。目的在于测定元器件和材料避免电击穿失效的能力。
- 第 3 部分:外部目检。目的在于验证半导体器件的材料、设计、结构、标志和工艺质量是否符合采购文件的要求。
- 第 4 部分:强加速稳态湿热试验(HAST)。目的在于规定强加速稳态湿热试验(HAST),以评价非气密封装半导体器件在潮湿环境下的可靠性。
- 第 5 部分:稳态温湿度偏置寿命试验。目的在于规定稳态温湿度偏置寿命试验,以评价非气密封装半导体器件在潮湿环境下的可靠性。
- 第 6 部分:高温贮存。目的在于在不施加电力条件下,确定高温贮存对半导体器件的影响。
- 第 7 部分:内部水汽测量和其他残余气体分析。目的在于考核封装过程的质量,并提供有关气体在管壳内的长期化学稳定性的信息。
- 第 8 部分:密封。目的在于检测半导体器件的漏率。
- 第 9 部分:标志耐久性。目的在于对半导体器件上的标志耐久性进行试验和验证。
- 第 10 部分:机械冲击。目的在于确定半导体器件和印制板组件承受中等严酷程度冲击的适应能力。
- 第 11 部分:快速温度变化 双液槽法。目的在于规定半导体器件的快速温度变化(双液槽法)的试验程序、失效判据等内容。
- 第 12 部分:扫频振动。目的在于测定在规定频率范围内,振动对半导体器件的影响。
- 第 13 部分:盐雾。目的在于确定半导体器件耐腐蚀的能力。
- 第 14 部分:引出端强度(引线牢固性)。目的在于测定半导体器件引线/封装界面和引线的牢固性。
- 第 15 部分:通孔安装器件的耐焊接热。目的在于确定通孔安装的固态封装半导体器件承受波峰焊或烙铁焊接引线产生的热应力的能力。
- 第 16 部分:粒子碰撞噪声检测(PIND)。目的在于规定空腔器件内存在自由粒子的检测方法。
- 第 17 部分:中子辐照。目的在于测定半导体器件在中子环境中性能退化的敏感性。
- 第 18 部分:电离辐射(总剂量)。目的在于提供了评估低剂量率电离辐射对半导体器件作用的加速退火试验方法。
- 第 19 部分:芯片剪切强度。目的在于确定半导体芯片安装在管座或基板上所使用的材料和工艺步骤的完整性。
- 第 20 部分:塑封表面安装器件耐潮湿和焊接热综合影响。目的在于通过模拟贮存在仓库或干燥包装环境中定了塑封表面安装半导体器件吸收的潮气,进而对其进行耐焊接热性能的评价。
- 第 20-1 部分:对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输。目的在于为对潮湿和焊接热综合影响敏感的塑封表面安装半导体器件承制方和用户提供操作、包装、运输和使用的方法。
- 第 21 部分:可焊性。目的在于规定了采用铅锡焊料或无铅焊料进行焊接的元器件封装引出端

的可焊性试验程序。

- 第 22 部分:键合强度。目的在于测量键合强度或确定键合强度是否满足规定的要求。
- 第 23 部分:高温工作寿命。目的在于规定随时间的推移,偏置条件和温度对固态器件影响的试验方法。
- 第 24 部分:加速耐湿 无偏置强加速应力试验。目的在于评价非气密封装固态器件在潮湿环境下的可靠性。
- 第 25 部分:温度循环。目的在于确定半导体器件、元件及电路板组件承受由极限高温和极限低温交变作用引发机械应力的能力。
- 第 26 部分:静电放电(ESD)敏感度测试 人体模型(HBM)。目的在于建立一种能够复现 HBM 失效的测试方法,以提供可靠、可重复的 HBM ESD 测试结果。
- 第 27 部分:静电放电(ESD)敏感度测试 机器模型(MM)。目的在于建立一种能够复现 MM 失效的测试方法,以提供可靠、可重复的 MM ESD 测试结果。
- 第 28 部分:静电放电(ESD)敏感度测试 带电器件模型(CDM) 器件级。目的在于建立一种能够复现 CDM 失效的测试方法,以提供可靠、可重复的 CDM ESD 测试结果。
- 第 29 部分:门锁试验。目的在于建立一种判断集成电路门锁特性的方法和规定门锁的失效判据。
- 第 30 部分:非密封表面安装器件在可靠性试验前的预处理。目的在于规定非密封表面安装器件在可靠性试验前预处理的标准程序。
- 第 31 部分:塑封器件的易燃性(内部引起的)。目的在于确定塑封器件是否由于过负荷引起内部发热而燃烧。
- 第 32 部分:塑封器件的易燃性(外部引起的)。目的在于确定塑封器件是否由于外部发热造成燃烧。
- 第 33 部分:加速耐湿 无偏置高压蒸煮。目的在于确认半导体器件封装内部失效机理。
- 第 34 部分:功率循环。目的在于通过对半导体器件内部芯片和连接器施加循环功率损耗来确定半导体器件耐热和机械应力能力。
- 第 35 部分:塑封电子元器件的声学显微镜检查。目的在于提供一种使用声学显微镜对塑封电子元器件进行缺陷(分层、裂纹、空洞等)检测的方法。
- 第 36 部分:稳态加速度。目的在于规定空腔半导体器件稳态加速度的试验方法,以检测其结构和机械类型的缺陷。
- 第 37 部分:采用加速度计的板级跌落试验方法。目的在于规定采用加速度计的板级跌落试验方法,对表面安装器件跌落试验可重复评估,同时复现产品级试验期间常见的失效模式。
- 第 38 部分:带存储的半导体器件的软错误试验方法。目的在于确立了带存储的半导体器件工作在高能粒子环境下(如阿尔法辐射)的软错误敏感性的试验方法。
- 第 39 部分:半导体器件用有机材料的潮气扩散率和水溶解度测量。目的在于确立了应用于半导体器件封装用有机材料的潮气扩散率和水溶解度的测量方法。
- 第 40 部分:采用应变仪的板级跌落试验方法。目的在于规定采用应变仪的板级跌落试验方法,对表面安装器件跌落试验可重复评估,同时复现产品级试验期间常见的失效模式。
- 第 41 部分:非易失性存储器可靠性试验方法。目的在于系统地规定了非易失性存储器有效耐久性、数据保持和温度循环试验的要求。
- 第 42 部分:温湿度贮存。目的在于规定了评价半导体器件耐高温高湿环境能力的试验方法。
- 第 44 部分:半导体器件的中子辐照单粒子效应(SEE)试验方法。目的在于确立了一种测量高密度集成电路单粒子效应(SEE)的试验方法。

GB/T 4937(所有部分)——对应采用 IEC 60749(所有部分),以保证半导体器件试验方法与国际标

准一致,实现半导体器件检验方法、可靠性评价、质量水平与国际接轨。通过制定该系列标准,确定统一的试验方法及应力,评价半导体器件的环境适应性,对半导体器件的研究、生产、检验和使用具有重要意义,同时补充完善半导体器件标准体系,为半导体器件行业的发展起到指导作用。

# 半导体器件 机械和气候试验方法

## 第 37 部分:采用加速度计的板级跌落试验方法

### 1 范围

本文件描述了一个在加速试验环境中评估和比较手持电子产品中表面安装器件跌落性能的试验方法,跌落试验过程中电路板过大弯曲会引起电子产品的失效。本文件目的是使试验电路板和试验方法标准化,能提供对表面安装器件跌落试验的可重复评估,使在产品级测试中可得到相同的失效模式。

本文件规定了一个标准的试验方法和报告要求。本文件与器件鉴定试验、判定手持电子产品合格与否的系统级跌落试验、模拟运输和搬运器件或印制电路板组件产生的相关振动试验不同,例如 GB/T 4937.10—2025 中规定了这些试验的方法要求。本方法适用于面阵列封装和四边引线表面安装封装。

本试验方法使用加速度计测量机械冲击的持续时间和振幅,振幅与安装在标准板上的给定器件的力的大小成比例。IEC 60749-40 中描述了一种使用应变仪测量器件周边电路板的应变和应变率的试验方法。详细规范说明使用的试验方法。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4937.10—2025 半导体器件 机械和气候试验方法 第 10 部分:机械冲击 器件和组件 (IEC 60749-10:2022, IDT)

IEC 60749-20 半导体器件 机械和气候试验方法 第 20 部分:塑封表面安装器件耐潮湿和焊接热综合影响 (Semiconductor devices—Mechanical and climatic test methods—Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat)

注: GB/T 4937.20—2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第 20 部分:塑封表面安装器件耐潮湿和焊接热综合影响 (IEC 60749-20:2008, IDT)

IEC 60749-20-1 半导体器件 机械和气候试验方法 第 20-1 部分:对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输 (Semiconductor devices—Mechanical and climatic test methods—Part 20-1: Handling, packing, labelling and shipping of surface-mount devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat)

注: GB/T 4937.201—2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第 20-1 部分:对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输 (IEC 60749-20-1:2009, IDT)

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。